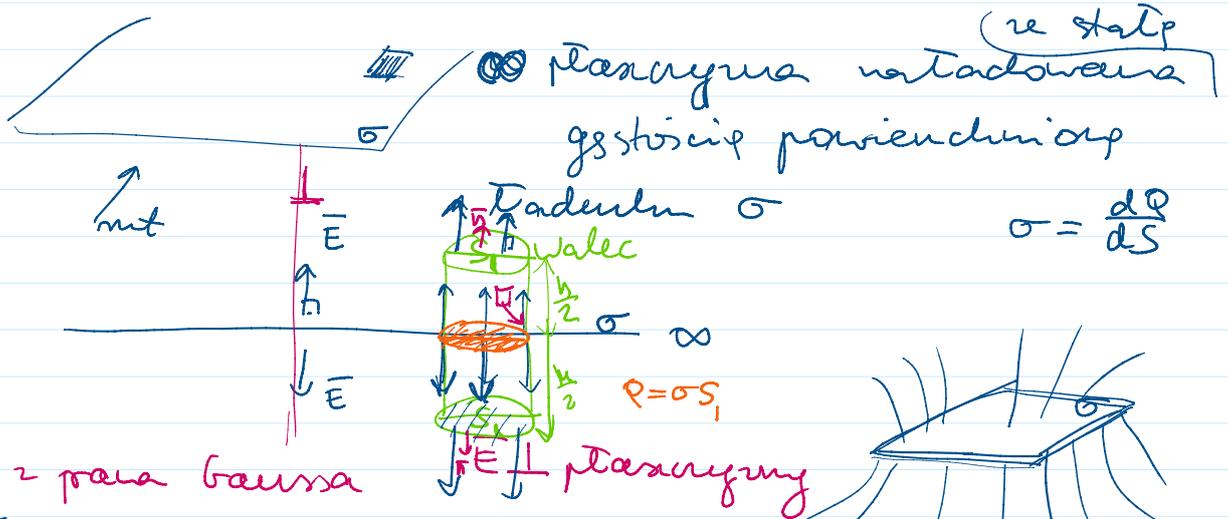


Kondensatory capacitor ← volume - objętość
 do gromadzenia ładunku równoległy capacity - pojemność
 capacitance

Kondensator płaski



Pole \vec{E} = para Gaussa

$$\oint \vec{E} d\vec{S} = \frac{Q}{\epsilon_0}$$

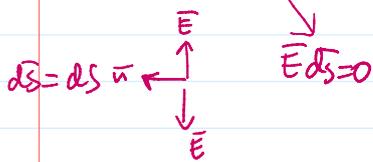
§ //

$$\int \vec{E} d\vec{S} + 2 \int \vec{E} d\vec{S} = \frac{Q}{\epsilon_0}$$

pow. bocznej

podst. //

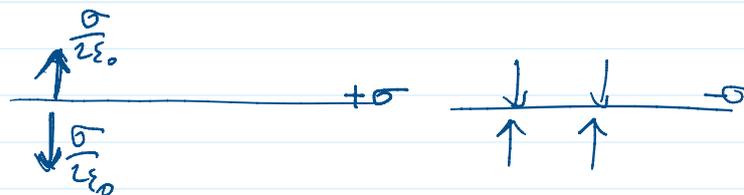
$$\sigma = \frac{Q}{S_1}$$



$$2 \int \vec{E} d\vec{S} = \frac{Q}{\epsilon_0}$$

$$2 E \left(\frac{h}{2}\right) \cdot S_1 = \frac{\sigma \cdot S_1}{\epsilon_0}$$

$$E = \frac{\sigma}{2\epsilon_0}$$



Dwie to płaskie: $\pm\sigma$, równoległe
 wypadkowe pole

powierz

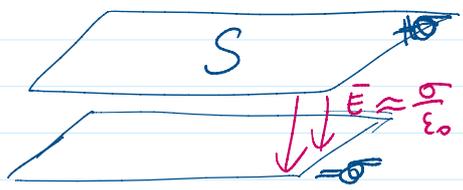
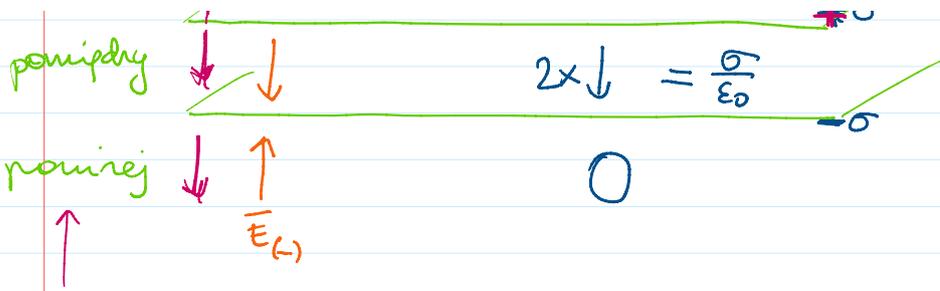


○

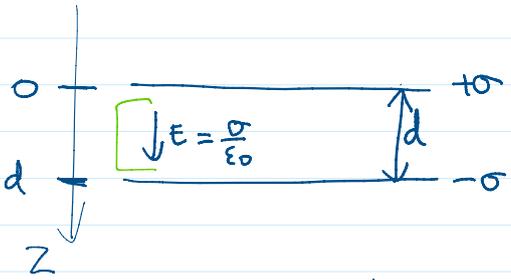
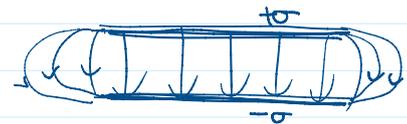
$$2 \times \downarrow = \frac{\sigma}{\epsilon_0}$$

$$\vec{E} = ?$$

powierz



2 dielektryki stańczone w przelazieniu



napięcie U lub V
Różnica potencjałów między płytami:

$$E = \frac{\sigma}{\epsilon \epsilon_0}$$

$$E = -\text{grad } \phi = -\frac{d\phi}{dz}$$

$$E dz = -d\phi \quad \phi(z) = -E \cdot z + \phi_0$$

Różnica potencjałów $\Delta\phi = U = \phi(0) - \phi(d) =$

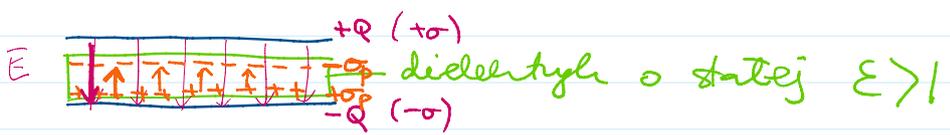
$$U = \frac{\sigma d}{\epsilon_0} \quad U = E d$$

$$U = \frac{Q d}{S \epsilon_0} \Rightarrow \left(\frac{Q}{U} \right) = \frac{Q}{V} = \frac{\epsilon_0 S}{d}$$

Stosunek $\frac{Q}{V}$ nazywamy pojemnością kondensatora C

$$C = \frac{Q}{V}$$

$$C = \frac{\epsilon_0 S}{d} \quad \text{dla kondensatora płaskiego}$$

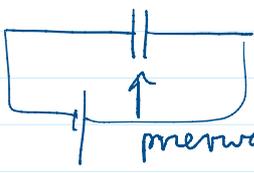


$C = \epsilon_0 S$ efektywne $\epsilon_0 \rightarrow \epsilon \epsilon_0$

-Q (+)

$$C_0 = \frac{\epsilon_0 S}{d} \rightarrow C = \frac{\epsilon \epsilon_0 S}{d} \quad \text{efektywne } \epsilon_0 \rightarrow \epsilon \epsilon_0$$

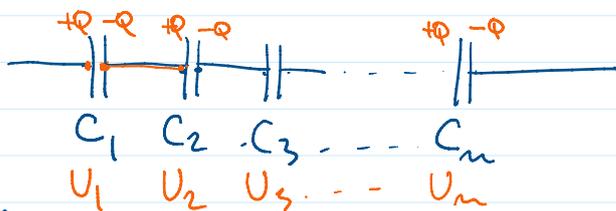
Pojemności kondensatora z dielektrykiem jest większa o czynnik ϵ .



omarczenie kondensatora w obwodzie elektr. nie przewodzi prądu stałego
przerwany obwód

Łączenie kondensatorów

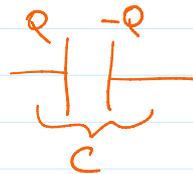
$$C = \frac{Q}{U}$$



(a) szeregowo

Jaka jest pojemności takiego układu?

$$U_i = \frac{Q}{C_i} \quad \text{dla każdego}$$



$$U = U_1 + U_2 + \dots + U_n$$

$$U = \frac{Q}{C_1} + \frac{Q}{C_2} + \dots$$

$$C = \frac{Q}{U}$$

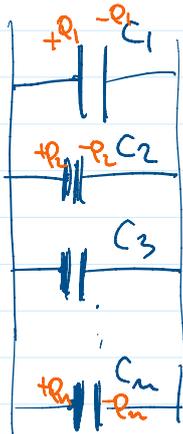
$$\frac{U}{Q} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \dots + \frac{1}{C_n} = \frac{1}{C}$$

Przykład szczególny: $C_1 = C_2 = \dots = C_n = C_0$

$$\frac{1}{C_0} + \frac{1}{C_0} + \dots + \frac{1}{C_0} = \frac{n}{C_0} = \frac{1}{C}$$

$$C = \frac{C_0}{n}$$

$$C = \frac{Q}{U}$$



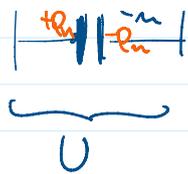
(b) równolegle

$$Q_i = U \cdot C_i$$

całkowity ładunek $Q = Q_1 + Q_2 + \dots + Q_n$

$$Q = U (C_1 + C_2 + \dots + C_n)$$

n



$$\varphi = U (C_1 + C_2 + \dots + C_n)$$

$$\frac{Q}{U} = C = C_1 + C_2 + \dots + C_n$$

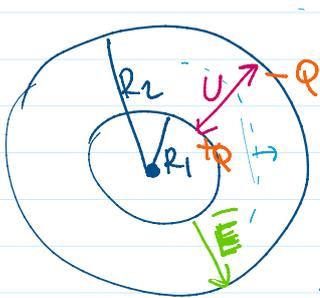
Gdy $C_1 = C_2 = \dots = C_0$ $C = n \cdot C_0$

Przykłady innych kondensatorów (o innej geometrii)

(płaski $C = \frac{\epsilon_0 S}{d}$) 

(1) kondensator kulisty

Pojemność: $C = \frac{Q}{U}$



2 sfery współśrodkowe o promieniach R_1 i R_2

pole E między sferami $E(r)$

r - promień od środka sfer

$$\oint E d\vec{S} = \frac{Q}{\epsilon_0} = E(r) \cdot 4\pi r^2$$

(a) $r < R_1$ $E(r) = 0$

(b) $R_1 < r < R_2$ $E(r) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{r^2}$

(c) $r > R_2$ $E(r) = 0$

(b) $E(r) = -\text{grad } \phi = -\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{r^2} = \left(\frac{d\phi}{dr}\right) \Rightarrow \phi(r) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{r} + \underline{\underline{\phi_0}}$

Różnica potencjałów w obszarze (b): $U = \phi(R_1) - \phi(R_2)$

$$U = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right)$$

$$C = \frac{Q}{U}$$

$$C = \frac{4\pi\epsilon_0}{\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2}} = \frac{4\pi\epsilon_0 R_1 R_2}{R_2 - R_1}$$

$$C = \frac{Q}{U}$$

$$C = \frac{4\pi\epsilon_0}{\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2}} = \frac{4\pi\epsilon_0 R_1 R_2}{R_2 - R_1}$$

Gdy odzwanyemy zewnętrzny okładkowy do ∞ : $R_2 \rightarrow \infty$



$$C \rightarrow 4\pi\epsilon_0 R_1$$

Jednostka pojemności: Farad: $1F = \frac{1C}{1V}$

(2) kondensator cylindryczny

